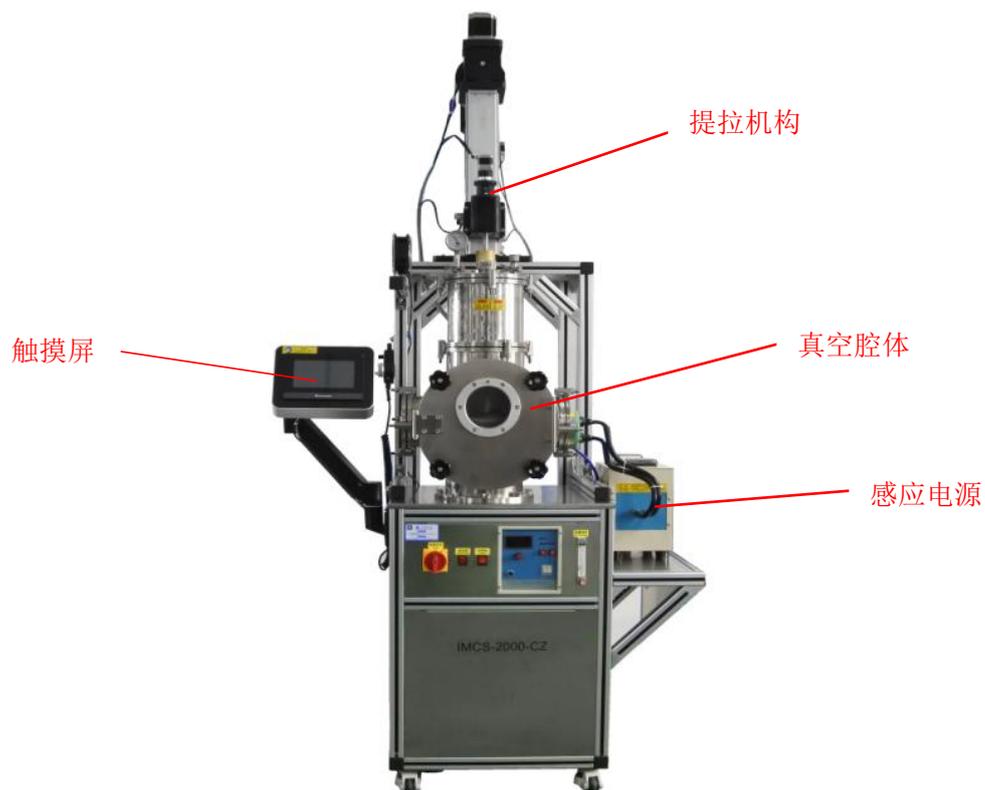


# 小型提拉法（CZ）单晶生长炉（可用于生长 直径<25mm，最高温度 2100℃）

## IMCS-2000-CZ



IMCS-2000-CZ 是一款小型的提拉法 (CZ) 晶体生长炉, 生长单晶直径 < 25mm。此设备最高温度可达 2100℃, 可用于生长 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, GGG, YAG, LaAlO<sub>3</sub>, Si, Ge 和各种金属单晶等。

### 技术参数

电源需求	输入电压: 380VAC, 三相 (需要 50A 空气开关) 感应加热最大输入电流 50A 最大输出功率 25KW
真空腔体	真空腔体采用 304 不锈钢制作 真空腔体尺寸: Φ 350×350mm 腔体门上有一石英窗口 (Φ 120mm), 用于观察材料熔化, 种籽晶和长晶过程 一个 KF25 接口和一个 KF40 真空接口在腔体后端 LF160 接口在腔体右侧, 用于连接分子泵系统。 
提拉机构	提拉机构采用精密伺服电机驱动 提拉速度: 0.1-10mm/h 提拉杆旋转速度: 0.1-23RPM 移动行程: 0-150mm 提拉机构可快速移动 35mm/min
真空&气氛	真空腔体可抽真空和通入惰性气氛 设备中配有一个数显防腐真空计 (传感器上涂油陶瓷涂层), 测量范围为 10 <sup>-5</sup> ~ 1000 torr 真空度: 6.7 x 10 <sup>-5</sup> torr (采用分子泵系统) 6.7×10 <sup>-2</sup> torr(采用机械泵) 可在本公司购买各种真空泵   
感应加热	25KW (30-80KHZ) 感应电源, 带有时间控制器和功率控制器 感应线圈: Φ 90mm×80mmH 其他尺寸线圈可定制

	<p>设备需要：116L/min 的循环水冷机(标配中含 KJ6200 水冷机)</p>
<p>控制面板</p>	<p>触摸屏控制面板 可控制提拉速度，提拉行程，籽晶杆转速和工作温度</p>
<p>应用注意事项</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>熔化材料</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>籽晶种入到熔液</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>提拉开始</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>生长的氧化铝单晶</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>生长的 Ni 单晶</p> </div> </div>
<p>设备尺寸</p>	<div style="text-align: center;">  <p>900mm      1100mm      2400mm</p> </div>